









	<h2 style="color: red;">IPB80N08S2L-07</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB80N08S2L-07
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPB80N08S2L-07 Infineon Technologies
	Datenblätter:	 IPB80N08S2L-07.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 8794 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N08S2L-07
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB80N08S2L-07 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8794 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	233nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

IPB80N08S2L-07 ist neu im Original, Suche IPB80N08S2L-07 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB80N08S2L-07 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB80N08S2L-07: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB80N08S2L-07(2N0807) INFINEO IPB80N08S2L-07(2N0807) INFINEO</p>	 <p>IPB80N06S4L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N08S207ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80P03P3L-04 VB VB P-TO263-3-2</p>
 <p>IPB80P03P4-05 VB VB PG-TO263-</p>	 <p>IPB80N08S406ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N06S4L07ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB80N07S405ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB65R280E6	↔ IPB65R310CFD	⇒ IPB65R310CFDA	D IPB65R380C6	⇒ IPB65R420CFD
⊣ IPB65R600C6	⊗ IPB65R660CFD	D IPB65R660CFDA	⇒ IPB70N04S3-07	⇒ IPB70N04S4-06
⊗ IPB70N10S2L-16	⊣ IPB70N10S3-12	⊗ IPB70N10S3L-12	↔ IPB70N10SL-16	⇒ IPB70P04P4-09
D IPB77N06S-09	⊗ IPB77N06S2-12	⊣ IPB77N06S3-09	⊗ IPB79CN10NG	⇒ IPB80N03S4L-02
⇒ IPB80N03S4L-03	↔ IPB80N04S2-04	⊗ IPB80N04S2-H4	⊣ IPB80N04S2L-03	⇒ IPB80N04S3-04
↔ IPB80N04S3-H4	⇒ IPB80N04S4-03	D IPB80N04S4-04	⊗ IPB80N04S4L-04	⊣ IPB80N06S2-05
⊗ IPB80N06S2-07	D IPB80N06S2-08	⇒ IPB80N06S2-09	↔ IPB80N06S2L-05	⇒ IPB80N06S2L-06
⊣ IPB80N06S2L-07	⊗ IPB80N06S2L-11	↔ IPB80N06S3-05	⇒ IPB80N06S3L-06	⇒ IPB80N06S3L-08
⊗ IPB80N06S4-05	⊣ IPB80N06S4-07	⊗ IPB80N06S4L-07	D IPB80N08S2-07	⇒ IPB80P03P4L-04
↔ IPB90N04S4-02	⊗ IPB90N06S4-04	⊣ IPB90N06S4L-04	⊗ IPB90R340C3	⇒ IPB6N03LAG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited